



(19)
 Bundesrepublik Deutschland
 Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 10 2008 024 808 B3 2009.11.26

(12)

Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2008 024 808.8

(22) Anmeldetag: 23.05.2008

(43) Offenlegungstag: –

(45) Veröffentlichungstag
 der Patenterteilung: 26.11.2009

(51) Int Cl.^B: **G01B 3/04** (2006.01)
B81B 1/00 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:

**Bundesrepublik Deutschland, vertr. d. d.
 Bundesministerium für Wirtschaft und
 Technologie, dieses vertr. d. d. Präsidenten der
 Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, 38116
 Braunschweig, DE**

(74) Vertreter:

**GRAMM, LINS & PARTNER GbR, 38122
 Braunschweig**

(72) Erfinder:

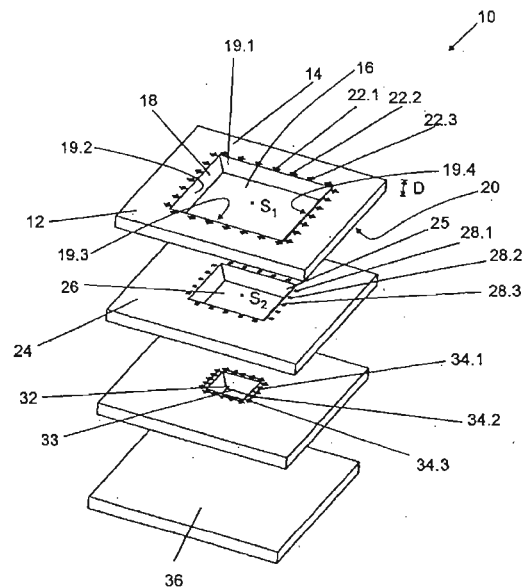
**Bütefish, Sebastian, Dr., 38229 Salzgitter, DE;
 Danzebrink, Hans-Ulrich, Dr., 38124
 Braunschweig, DE**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
 gezogene Druckschriften:

DE	18 43 021	U
DE	38 06 791	C1
DE	298 22 001	U1
JP	62-0 42 010	AA
US	2002/01 57 449	A1
DE	10 2004 022750	A1
DE	103 42 689	B3

(54) Bezeichnung: Geometrienormal und Verfahren zum Herstellen eines Millimeterbereich-Längennormals

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Geometrienormal, das eine erste Platte (12), die eine Erstplatten-Ausnehmung (16) aufweist, die von einem Erstplatten-Rand (18) begrenzt ist, und zumindest eine zweite Platte (24), die mit der ersten Platte (12) verbunden ist umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Platte (12) und die zweite Platte Einkristalle (24) sind, der Erstplatten-Rand (18) entlang einer Kristallebene der ersten Platte (12) verläuft und die zumindest eine zweite Platte (24) eine Zweitplatten-Ausnehmung (26) aufweist, die von einem Zweitplatten-Rand (25) begrenzt wird, der entlang einer Kristallebene der zweiten Platte (24) verläuft, sodass sich die Erstplatten-Ausnehmung (16) und die Zweitplatten-Ausnehmung (26) zu einer gemeinsamen Ausnehmung ergänzen.



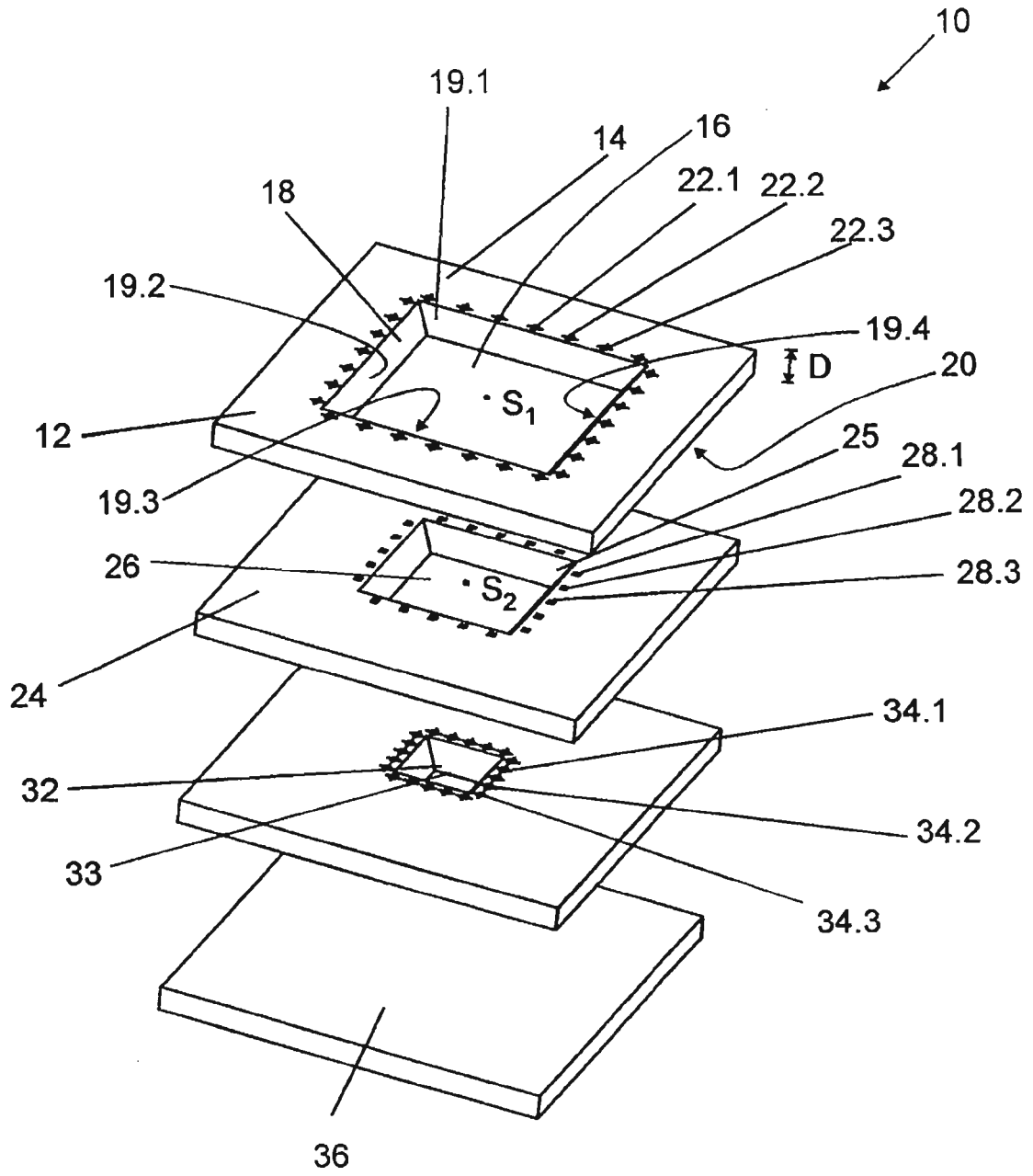


Fig. 1

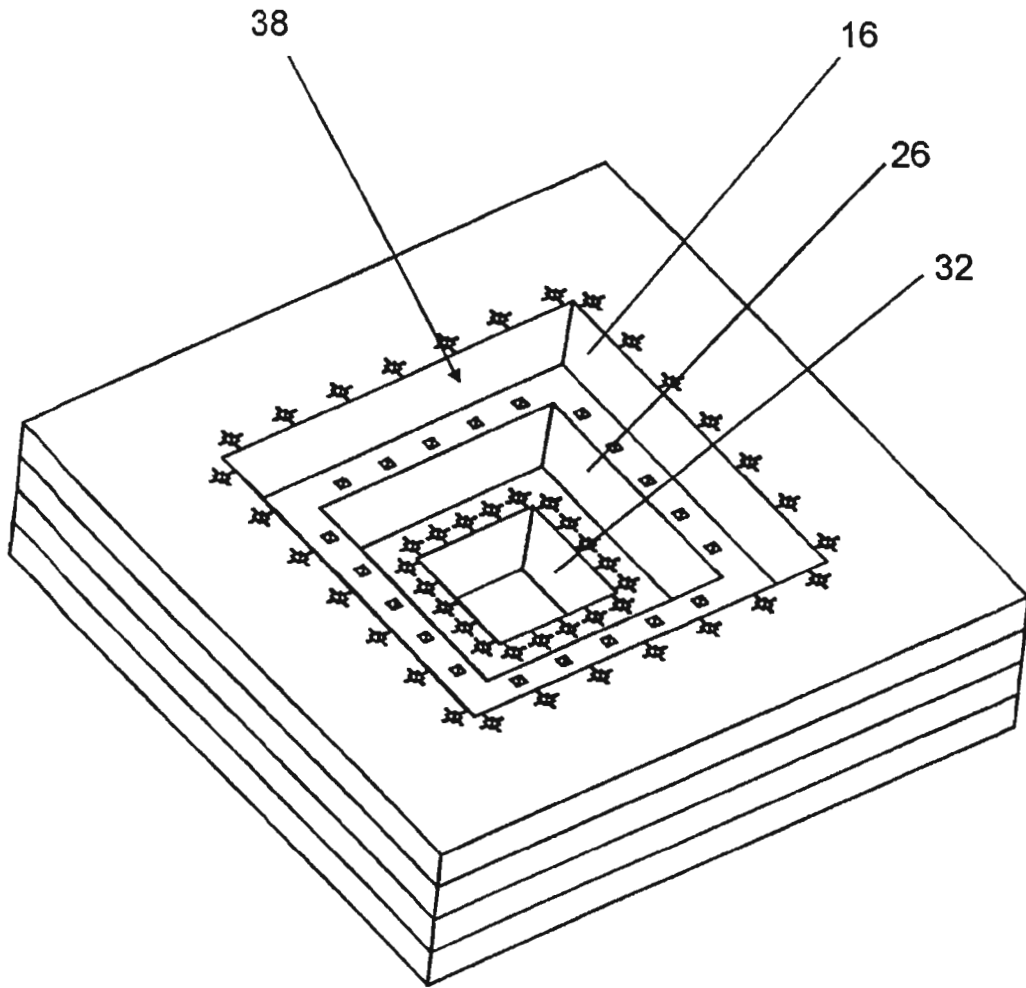


Fig. 2

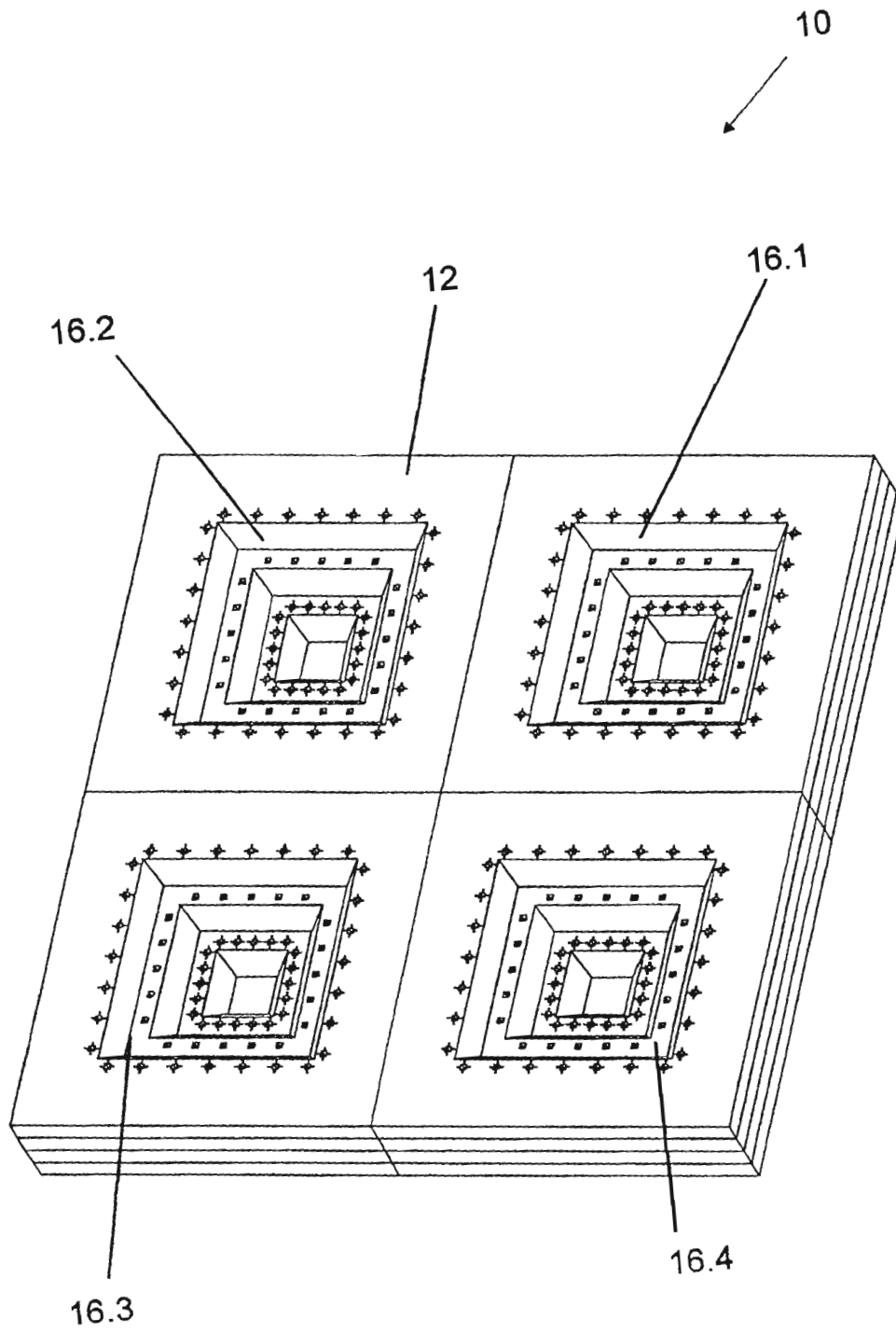


Fig. 3

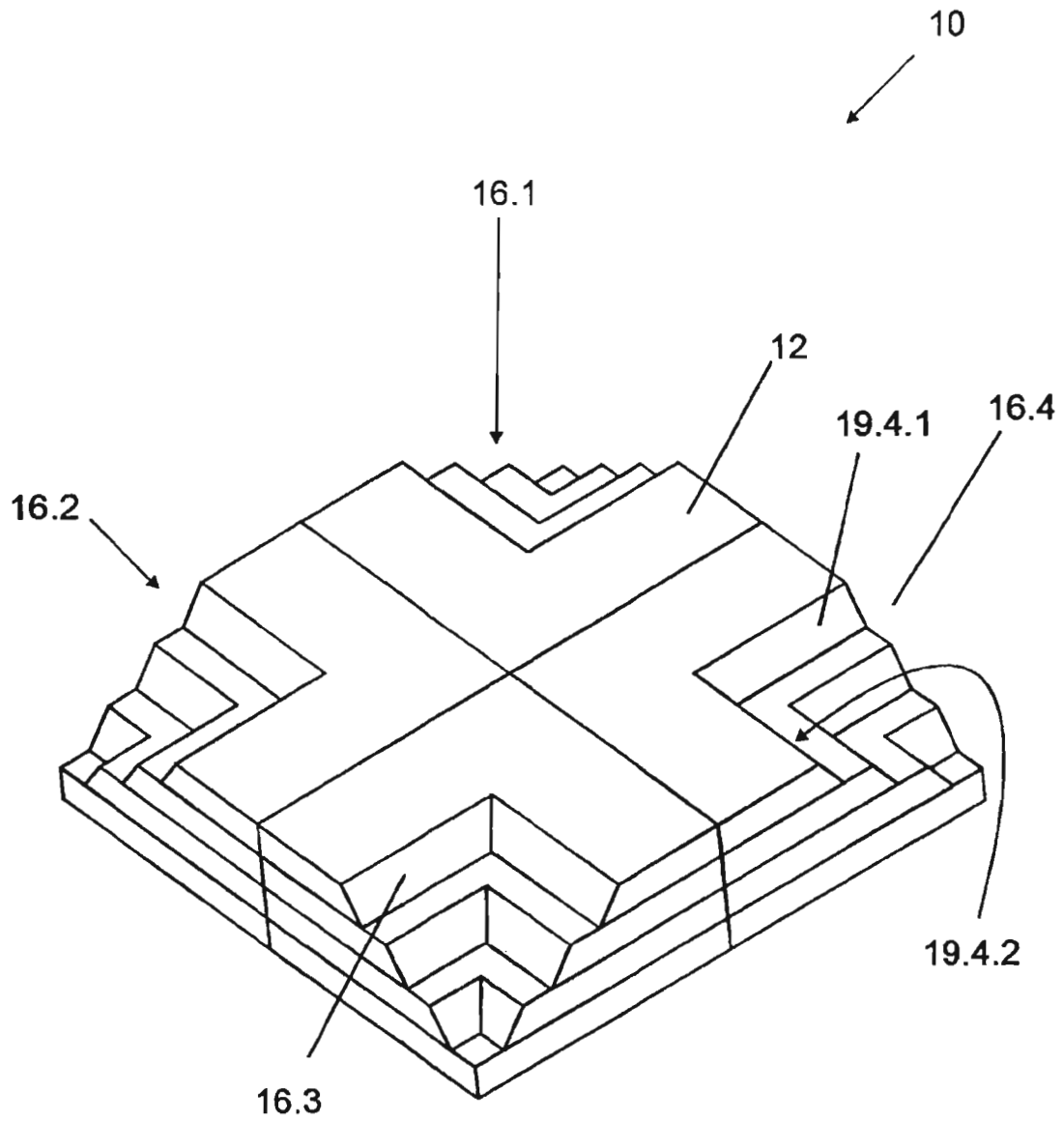


Fig. 4

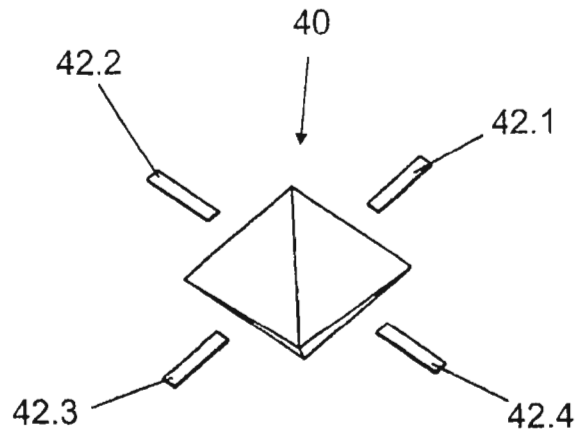


Fig. 5a

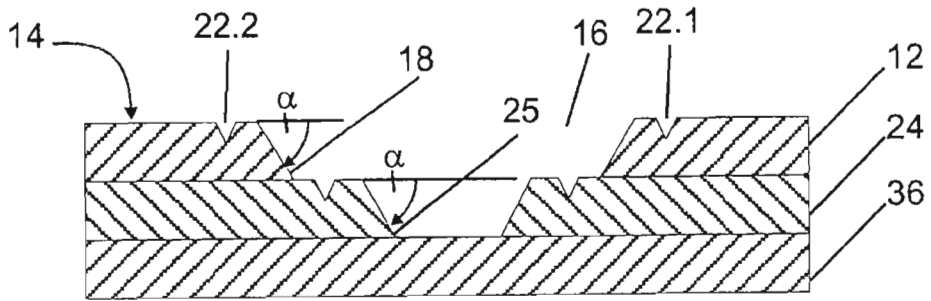


Fig. 5b

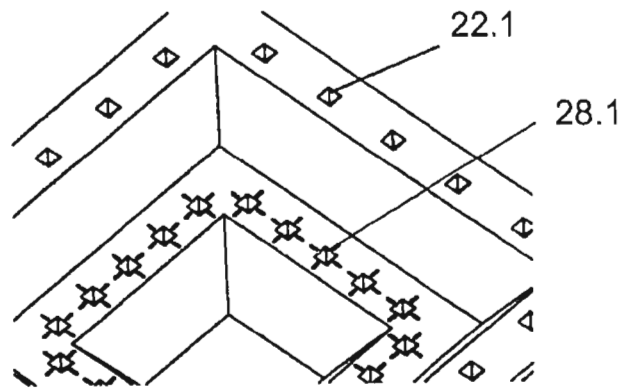


Fig. 5c

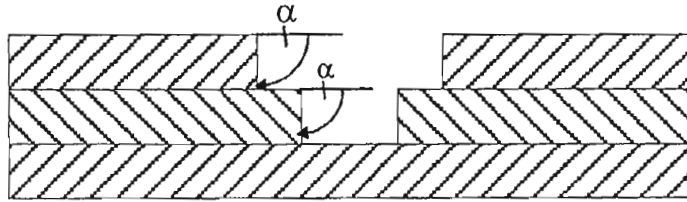


Fig. 6a

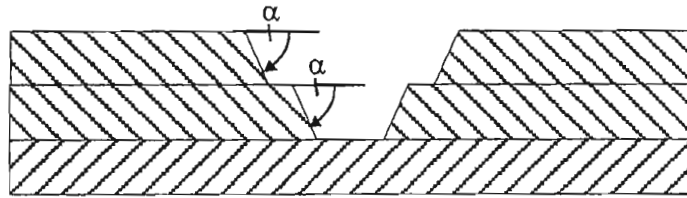


Fig. 6b

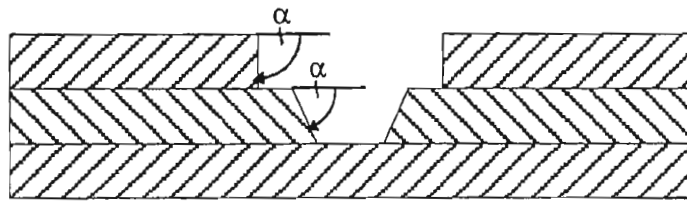


Fig. 6c

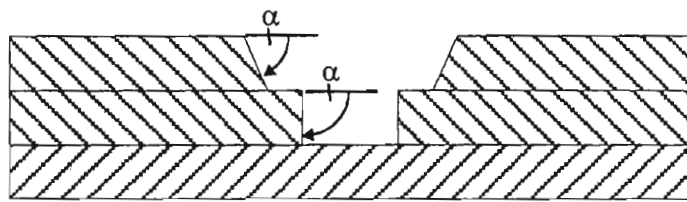


Fig. 6d

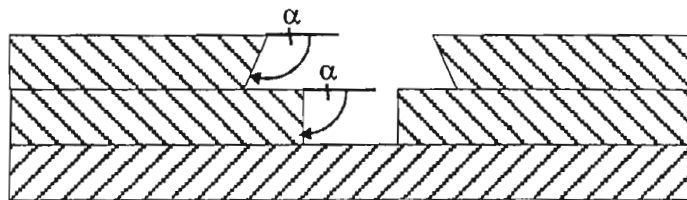


Fig. 6e